

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПРУГИХ ДИПОЛЕЙ И ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ВИРТУАЛЬНЫХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКАХ

М. Д. Глинчук, И. М. Смолянинов

Известно, что многие кооперативные свойства примесей в кристалле зависят от вида их взаимодействия, причем в структурно-неустойчивых решетках появляется ряд особенностей во взаимодействии примесей [1-4], которые могут приводить как к переходу в упорядоченное состояние, так и в состояние стекла.

В настоящей работе показано, что в «мягких» решетках в энергии взаимодействия упругих диполей появляются дальнодействующие вклады, которые могут приводить при определенных условиях к сегнетоэластическому упорядочению. Сделана оценка температуры такого фазового перехода и ее зависимости от концентрации упругих диполей.

Энергия взаимодействия упругих диполей с полем деформации решетки $u_{\alpha\beta}$ ($\alpha, \beta = x, y, z$) имеет вид [5]

$$H_{int} = - \sum_{i, \alpha, \beta} \Omega_{\alpha\beta}(r_i) u_{\alpha\beta}(r_i), \quad (1)$$

$\Omega_{\alpha\beta}$ — компоненты тензора упругого диполя в точке r_i . Для нецентральной примеси, смещенной вдоль [100] в кубической решетке, тензор упругого диполя можно записать

$$\Omega_{\alpha\beta} = \Omega_1 T_{\alpha\beta}(1) + \Omega_2 T_{\alpha\beta}^1(2), \quad (2)$$

где $\Omega_1 = (\Omega_x + 2\Omega_z)/\sqrt{3}$, $T_{\alpha\beta}(1) = \delta_{\alpha\beta}/\sqrt{3}$; $\Omega_2 = 2(\Omega_x - \Omega_z)/\sqrt{6}$, $T_{\alpha\beta}^1(2) = (3l_\alpha l_\beta - \delta_{\alpha\beta})/\sqrt{6}$; $\Omega_{xx} = \Omega_1$, $\Omega_{zz} = \Omega_1 \neq \Omega_x$, $\Omega_x > \Omega_z$; l — единичный вектор, направленный вдоль оси диполя. Первое слагаемое в (2) представляет дилатационную часть, второе слагаемое — квадрупольную часть, связанную с нецентральностью положения примеси. Используя (1) и (2), во втором порядке теории возмущения находим гамильтониан косвенного взаимодействия упругих диполей через акустические фононы

$$H_{\phi\phi}^{ak} = \sum_{i,j} \left\{ \sum_{\beta} \Omega_{\frac{x}{2}}(r_i) \Omega_1(r_j) T_{\frac{x}{2}\beta}(2) V_1^{\beta\beta}(r_{ij}) + \sum_{\beta} \Omega_{\frac{x}{2}}(r_i) \Omega_{\frac{x}{2}'}(r_j) T_{\frac{x}{2}\beta}(2) T_{\frac{x}{2}\beta}'(2) V_2^{\beta\beta}(r_{ij}) - \sum_{\substack{\beta, \beta' \\ \beta \neq \beta'}} \Omega_{\frac{x}{2}}(r_i) \Omega_{\frac{x}{2}'}(r_j) T_{\frac{x}{2}\beta}(2) T_{\beta'\beta'}(2) V_3^{\beta\beta'}(r_{ij}) \right\}, \quad (3)$$

$$V_1^{\beta\beta}(r_{ij}) = \frac{1}{4\sqrt{3}\pi c_{11}} \left[\frac{1}{r_{ij}^3} - \frac{3(r_{ij}^\beta)^2}{r_{ij}^5} \right],$$

$$V_2^{\beta\beta}(r_{ij}) = \frac{1}{16\pi c_{11}} \left[\frac{1}{r_{ij}^3} + \frac{6(r_{ij}^\beta)^2}{r_{ij}^5} - \frac{15(r_{ij}^\beta)^4}{r_{ij}^7} \right],$$

$$V_3^{\beta\beta'}(r_{ij}) = \frac{1}{16\pi c_{11}} \left\{ \frac{1}{r_{ij}^3} - \frac{3[(r_{ij}^\beta)^2 + (r_{ij}^{\beta'})^2]}{r_{ij}^5} + \frac{15(r_{ij}^\beta)^2(r_{ij}^{\beta'})^2}{r_{ij}^7} \right\}.$$

Выражение (3) получено в приближении упругоизотропной среды ($c_{11} = c_{12}$)/2 = c_{44} (c_{11} , c_{12} , c_{44} — коэффициенты упругости для кубической решетки).

Упругие диполи могут взаимодействовать и с оптическими фононами через электрострикционную связь

$$u_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta\gamma\delta} P_\gamma P_\delta, \quad (4)$$

$g_{\alpha\beta\gamma\delta}$ — коэффициенты электрострикции ($g_{11} = g_{aaa}$, $g_{12} = g_{aa\beta\beta}$), P_γ — компоненты вектора поляризации. Для вычисления косвенного взаимодействия

вия упругих диполей через «мягкие» оптические фононы с законом дисперсии $\omega_q^2 = \omega_0^2(T) + s^2 q^2 (\omega_0(T) — частота «мягкого» фона)$ применялся метод температурных функций Грина. Используя выражения (1), (4), во втором порядке теории возмущения получаем

$$H_{\text{вф}}^{\text{оп}} = -kTG^2 \sum_{i,j} \left\{ B(r_i) B(r_j) \sum_{\beta, \beta'} I_{\beta\beta'}(r_{ij}) + \sum_{\beta} A^{\alpha}(r_i) B(r_j) T_{\beta\beta}^{\alpha}(2) \sum_{\beta'} I_{\beta\beta'}(r_{ij}) + A^{\alpha}(r_i) A^{\alpha'}(r_j) \left[\sum_{\beta} T_{\beta\beta}^{\alpha}(2) T_{\beta\beta'}^{\alpha'}(2) I_{\beta\beta'}(r_{ij}) + \sum_{\beta, \beta'} T_{\beta\beta}^{\alpha}(2) T_{\beta'\beta'}^{\alpha'}(2) I_{\beta\beta'}(r_{ij}) \right] \right\}, \quad (5)$$

G — эффективный заряд «мягкой» оптической ветви, $A^{\alpha}(r_i) = (q_{11} - q_{12}) \Omega_2^{\alpha}(r_i)$, $B(r_i) = (q_{11} + 2q_{12}) \Omega_1(r_i)/\sqrt{3}$. Аналитический вид членов выражения (5) от r_{ij} зависит от температурного интервала:

а) высокие температуры $T \geq T_d/2$ (T_d — температура Дебая)

$$\left. \begin{aligned} \sum_{\beta, \beta'} I_{\beta\beta'}(r_{ij}) &= \frac{1}{(2\pi\omega_0^2)^2} [3C^2(r_{ij}) + 6D^2(r_{ij})], \\ \sum_{\beta'} I_{\beta\beta'}(r_{ij}) &= \frac{3(x_{ij}^{\beta})^2}{(2\pi\omega_0^2)^2} [2C(r_{ij}) D(r_{ij}) + D^2(r_{ij})], \\ I_{\beta\beta}(r_{ij}) &= \frac{1}{(2\pi\omega_0^2)^2} \{C(r_{ij}) - [1 - 3(x_{ij}^{\beta})^2] D(r_{ij})\}^2, \\ I_{\beta\beta'}(r_{ij}) &= \frac{9(x_{ij}^{\beta})^2 (x_{ij}^{\beta'})^2}{(2\pi\omega_0^2)^2} D^2(r_{ij}); \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

в (6) введены обозначения $x_{ij}^{\beta} = r_{ij}^{\beta}/r_{ij}$, $r_c = s/\omega_0$ — радиус корреляции решетки,

$$C(r_{ij}) = 2 \exp(-r_{ij}/r_c)/(3r_{ij}^2 r_{ij}), \quad D(r_{ij}) = 1/r_{ij}^3 - \exp(-r_{ij}/r_c) \times [1/r_{ij}^3 + 1/(r_c r_{ij}^2) + 1/(3r_{ij}^2 r_{ij})];$$

б) низкие температуры $kT \leq \hbar\omega_0/2$ ($r_{ij} \leq r_c$)

$$\left. \begin{aligned} \sum_{\beta, \beta'} I_{\beta\beta'}(r_{ij}) &= \frac{3\hbar}{16\pi^3 k T s^3} \left[\frac{1}{9r_{ij}^3} + \frac{(\pi r_c)}{r_{ij}^4} + \frac{4 \ln(r_{ij}/r_c)}{3r_{ij}^3} \right], \\ \sum_{\beta'} I_{\beta\beta'}(r_{ij}) &= \frac{3\hbar(x_{ij}^{\beta})^2}{32\pi^3 k T s^3} \left[\frac{(\pi r_c)}{r_{ij}^4} - \frac{4 \ln(r_{ij}/r_c)}{3r_{ij}^3} \right], \\ I_{\beta\beta}(r_{ij}) &= \frac{\hbar}{32\pi^3 k T s^3} \left\{ \frac{2}{9r_{ij}^3} + \frac{8[1 - 3(x_{ij}^{\beta})^2] \ln(r_{ij}/r_c)}{3r_{ij}^3} + \right. \\ &\quad \left. + [1 - 3(x_{ij}^{\beta})^2]^2 \left[\frac{(\pi r_c)}{r_{ij}^4} + \frac{4 \ln(r_{ij}/r_c)}{3r_{ij}^3} \right] \right\}, \\ I_{\beta\beta'}(r_{ij}) &= \frac{9\hbar(x_{ij}^{\beta})^2 (x_{ij}^{\beta'})^2}{32\pi^3 k T s^3} \left[\frac{(\pi r_c)}{r_{ij}^4} + \frac{4 \ln(r_{ij}/r_c)}{3r_{ij}^3} \right]. \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

При $r_{ij} > r_c$ зависимость от r_{ij} в (7) имеет сложную аналитическую структуру и выражается через функции Бесселя, которые в предельном случае $r_{ij} \gg r_c$ содержит члены вида $\sim \exp(-r_{ij}/r_c)/(r_{ij}^{1/2} r_c^{1/2})$. Используя значения величин G , q_{11} , q_{12} для КТаО₃ [6], находим, что $H_{\text{вф}}^{\text{ак}} \sim H_{\text{вф}}^{\text{оп}}$. Для $n r_c^3 \gg 1$ (n — концентрация примесей) основной вклад в $H_{\text{вф}}^{\text{оп}}$ вносят знакопостоянные члены $\sim \exp(-2r_{ij}/r_c)/r_{ij}^2$, тогда как все слагаемые в $H_{\text{вф}}^{\text{ак}}$ знакопеременные и $H_{\text{вф}}^{\text{ак}} \sim 1/r_{ij}^3$. Легко видеть, что для обычных диэлектриков с нецентральными примесями (например, KCl:Li) $H_{\text{вф}}^{\text{ак}} \gg H_{\text{вф}}^{\text{оп}}$ и все аномалии физических величин, связанных с упругим взаимодействием, определяются $H_{\text{вф}}^{\text{ак}}$, а для «мягких» решеток обязателен учет $H_{\text{вф}}^{\text{оп}}$.

Оценим условия возникновения сегнетоэластического перехода. Для $nr_c^3 \gg 1$ и $T \geq T_d/2$ в (6) $C(r_{ij}) > D(r_{ij})$, что приводит к

$$H_{\alpha\beta}^{\text{оп}} = - \sum_{i,j,\beta} V(r_{ij}) \Omega_2(\mathbf{r}_i) \Omega_2(\mathbf{r}_j) T_{\beta\beta}^{\alpha}(2) T_{\beta\beta}^{\alpha}(2), \quad (8)$$

$$V(r_{ij}) = \{kT[G(q_{11} - q_{12})]^2/(54\pi^2 s^4)\} \exp(-2r_{ij}/r_e)/r_{ij}^2.$$

Используя (8), в приближении среднего поля ($z \gg 1$, $z = nr_c^3/2$ — среднее число соседей) получаем «смягчение» для $c_{11} - c_{12}$ при $T > T_c$ (T_c — температура сегнетоэластического перехода)

$$c_{11} - c_{12} = c_{11}(T = \infty) - c_{12}(T = \infty) - n(\Omega_{\parallel} - \Omega_{\perp})^2/3k(T - T_c). \quad (9)$$

Для КТаO₃ с концентрацией примесей Li $n \sim 10 \div 15\%$ и $\Omega_{\parallel} - \Omega_{\perp} \sim 1 \div 5 \cdot 10^{-19}$ Дж, получаем $T_c \leq 100$ К, а концентрационная зависимость T_c имеет вид $T_c \sim n^{1/4}$. В [7, 8] наблюдалось «смягчение» упругих модулей $c_{11} - c_{12}$, при этом c_{44} практически не зависел от температуры, что может свидетельствовать о существовании сегнетоэластического перехода. Приведенное выше рассмотрение годится для $nr_c^3 \gg 1$ ($n \geq 10\%$), где справедливо приближение среднего поля. Вопрос о низкотемпературной фазе при $nr_c^3 \ll 1$ более сложный, так как $H_{\alpha\beta}^{\text{оп}} \gg H_{\alpha\beta}^{\text{ак}}$. Это должно приводить к состоянию ориентационного стекла, но присутствие в (3) членов типа «случайное поле деформации» значительно осложняет рассмотрение структуры низкотемпературной фазы.

Авторы благодарны В. С. Вихнину и Н. К. Юшину за обсуждение результатов.

Л и т е р а т у р а

- [1] Вугмейстер Б. Е., Глинчук М. Д. УФН, 1985, т. 146, № 3, с. 459—491.
- [2] Вихнин В. С. ФТТ, 1981, т. 23, № 8, с. 2370—2375.
- [3] Dugaev V. K., Litvinov V. J., Tovstyuk K. D. Phys. Lett., 1982, vol. 92A, N 4, p. 186—188.
- [4] Ивлев М. П., Сахненко В. П. ФТТ, 1986, т. 28, № 2, с. 632—634.
- [5] Лейбфрид Г., Броудер Н. Точечные дефекты в металлах. М.: Мир, 1981. 439 с.
- [6] Uwe H., Sacudo J. Phys. Rev. B, 1977, vol. 15, N 1, p. 337—345.
- [7] Höchli H. T., Weibel H. E., Rehwald W. J. Phys. C, 1982, vol. 15, № 30, p. 6129—6140.
- [8] Смоленский Г. А., Сотников А. В., Сырников П. П., Юшин Н. К. Изв. АН СССР, сер. физ., 1983, т. 47, № 3, с. 603—606.

Институт проблем материаловедения
АН УССР
Киев

Поступило в Редакцию
27 июля 1987 г.
В окончательной редакции
5 ноября 1987 г.

УДК 538.1

Физика твердого тела, том 30, в. 4, 1988
Solid State Physics, vol. 30, N 4, 1988

СУЩЕСТВОВАНИЕ МАГНИТОДИСТОРСИОННОЙ ФАЗЫ В ЯН-ТЕЛЛЕРОВСКИХ АНТИФЕРРОМАГНЕТИКАХ

B. Г. Вехтер

1. В кристаллах, обладающих ионной подрешеткой с вырожденным основным состоянием, с понижением температуры происходят фазовые переходы в упорядоченную фазу, где это вырождение снято. Если указанное вырождение крамерсово, то переход оказывается магнитным. Если вырождение некрамерсово, то поскольку оно может быть снято как магнитными, так и электростатическими воздействиями, возможны как маг-